

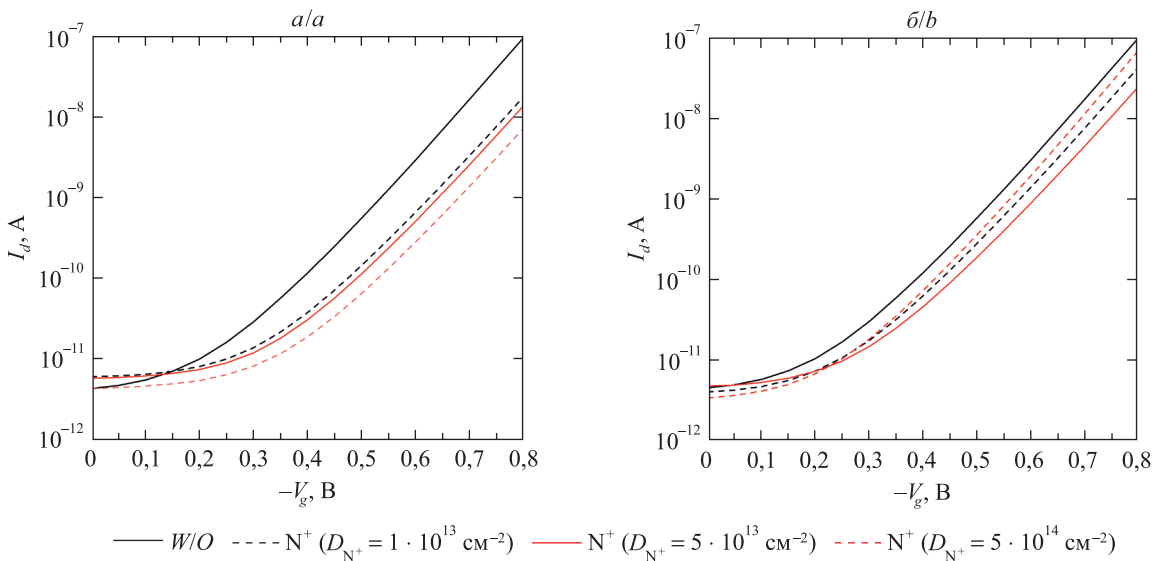


Рис. 7. Зависимости тока стока (I_d) и крутизны ВАХ (Δg_m) МОП-транзисторов в триодном режиме ($V_d = -0,1$ В) от напряжения на затворе (V_g) в диапазоне 0–0,8 В для контрольных (W/O) и имплантированных (N^+) образцов:
 a – прямой порядок БТО; b – обратный порядок БТО

Fig. 7. Dependences of the drain current (I_d) and the current-voltage slope (Δg_m) of MOSFETs in the triode mode ($V_d = -0.1$ V) on the gate voltage (V_g) in the range 0–0.8 V for control (W/O) and implanted (N^+) samples:
 a – direct order of rapid thermal annealing; b – reverse order of rapid thermal annealing